

59

BEST AVAILABLE COPY

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827, 438/464, 438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally wax 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning receiver 14 and heating by a heater 12 and then the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO&Japic

12 公開特許公報 (A)

昭60-10756

54 Int. Cl.
H 01 L 21/92

識別記号

序内整理番号
7638 5F

43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリード型半導体装置の製造方法

東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

公特 願 昭58-119143

出願人 日本電気株式会社

公出 願 昭58(1983)6月30日

東京都港区芝五丁目33番1号

発明者 純巻京雄

代理人 弁理士 内原晋

明細書

1. 発明の名称

ビームリード型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ビームリード型半導体装置の形成されたウェーハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェーハーを裏面から選択的にエッティング除去してペレットに分離する工程と、前記ワックスを溶しへレット吸着用治具にて前記平板から前記ペレットを分離する工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、貯められた洗浄用受け皿内にて、貯めた有機溶剤によってワックスを除去する工程とを含むことを特徴とするビームリード型半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な内容

本発明はビームリード型半導体装置の製造方法に関するもの。

従来ビームリード型半導体装置の製造方法は、所定のビームリード型半導体素子の形成された半導体基板の上面にワックスを塗布し石英板と貼り合せし後、該半導体基板の裏面にレジストにてパターンを形成し前記基板で半導体ウェーハーを選択的にエッティング除去してペレット状に分離し、次にペレット1個1つ分離して再配列するのに100～200回の高周波のホットプレート上でワックスを溶しへレット吸着用治具にてペレットと石英板とを分離後、半導体ペレットに付着ワックスを予め加熱ヒーターで有機溶剤を貯めた有機溶剤をスプレーガンで3～5分間吹付けて除去し別の配列板に並べていた。

しかし上記方式のペレットハンドリングプロセスは、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石英板とがワックスによって貼り合はされておりこのワックスを100～200回の高周波のホットプレート上で石英板と離れてワックスを落かし、ペレットが石英板と離れてペレットと石英板とを分離後、

半導体ペレットの配列面及び裏面に付着しているワックスを、50～100℃の該温度の加熱ヒーターにて予め有機用剤を含めスプレーガンで吹付時3.0～3.5℃範囲の有機溶剤を3～5秒間吹付けてワックスを除去し別の配列板に並べているがペレットサイズによってワックス洗浄に時間がかかりまたワックスが完全に取りきれない場合もあった。

ペレットの配列面及び裏面にワックスが残っていると、ペレットの信頼性及び歩留りを悪くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を長くしたりするため作業能率を悪くする欠点を残っていた。

本発明は上記欠点を除去し半導体装置の信頼性及び製造歩留りを大幅に向上させることのできる半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体粒子の形成されたウェーハーを返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェーハーを裏面から選択的にエッティング除去してペレットに分割する工

- 3 -

離する。

次に図3に示すようにペレット15の配列面及び裏面に付着しているワックス13を50～100℃の該温度範囲の加熱ヒーター21によって予め有機溶剤と、洗浄用溶剤18も加熱ヒーター19によって50～100℃の該温度範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付時3.5～4.0℃範囲の有機溶剤を3～4秒間吹付けてワックスを除去した(第4回)後、別の配列板22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペレットの配列面及び裏面に付着しているワックスを予め吸めた有機溶剤と吹付用受け皿も含めることにより有機溶剤を高圧でペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩留り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに關係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

- 5 -

-282-

野と、加熱によりワックスを付着したペレットの裏面からペレットを分離する工程と、前記ペレットの裏面から付着しているワックスを、擦りむられか等に露出させて、吸めた有機溶剤にて除去する工程と、前記ペレットを分割する工程とを含む半導体装置の製造方法である。

以下歩骤例に基づき断面を参照して本発明を詳細に説明する。

まず第1回に示すように、周囲のビームリード型粒子の形成された半導体ウェーハーを、前記ビームリード2が下になるよう裏返して、例えばスカイコートなどのワックス3を用いて石英などの平板4に貼り付ける。

次に前記半導体ウェーハーの裏面にレジストバターンを形成し、该バターンをマスクにして酸洗液を用いて該ウェーハーを選択的にエッティング加工し、第2回に示すようにペレット5に分離する。次に100～200℃のホットプレート7の上で石英板4を摩めてワックス3を付着したペレット表面用溶剤6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1回乃至第4回は本発明の実施例を説明する為の断面図である。

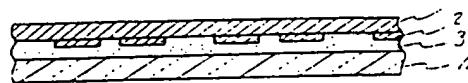
1 ……半導体ウェーハー、2 ……ビームリード、3 ……ワックス、4 ……石英板、5 ……ペレット、6 ……ペレット表面用溶剤、7 ……ホットプレート、18 ……洗浄用受け皿、19 ……洗浄用受け皿の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……有機溶剤の加熱ヒーター、22 ……ガラス板である。

代理人弁理士 内原

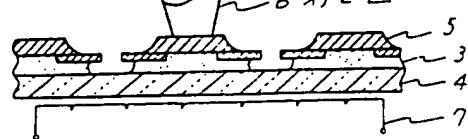
音(印)

- 6 -

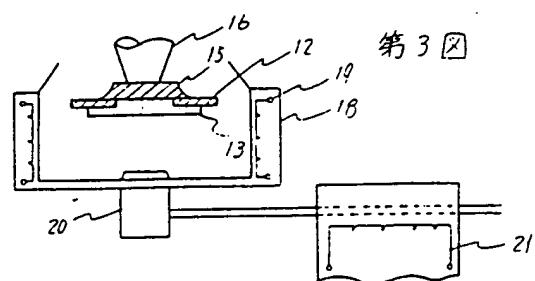
第1図



第2図



第3図



第4図

